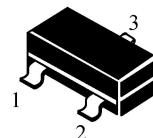


GMA1037AK

SOT-23

1. BASE  
2. EMITTER  
3. COLLECTOR



■FEATURES 特點

PNP General Purpose Transistor

■MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ) 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	$V_{CBO}$	-60	V
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	$V_{CEO}$	-50	V
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	$V_{EBO}$	-6	V
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	$I_c$	-150	mA
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	$P_C$	225	mW
Junction Temperature 結溫	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range 儲存溫度	$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

■DEVICE MARKING 打標

GMA1037AK	Q	R	S
MARK	FQ	FR	FS
$H_{FE}$	120~270	180~390	270~560

GMA1037AK

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-60\text{V},$ $I_E=0$	—	—	-0.1	$\mu\text{A}$
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-6\text{V},$ $I_C=0$	—	—	-0.1	$\mu\text{A}$
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-50\mu\text{A}$	-60	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-1.0\text{mA}$	-50	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-50\mu\text{A}$	-6	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$H_{FE}$	$V_{CE}=-6\text{V},$ $I_C=-1\text{mA}$	120	—	560	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-50\text{mA},$ $I_B=-5\text{mA}$	—	—	-0.5	V
Transition Frequency 特徵頻率	$f_T$	$V_{CE}=-12\text{V},$ $I_C=-2\text{mA},$ $f=100\text{MHz}$	—	140	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	$C_{ob}$	$V_{CB}=-12\text{V},$ $I_E=0\text{A},$ $f=1\text{MHz}$	—	4.0	5.0	pF